多层及交替多层 NdFeB/Nd 薄膜的磁性能

张敏刚,刘丽,陈峰华,李敏杰

(太原科技大学, 山西 太原 030024)

摘 要:采用磁控溅射法制备了 NdFeB/Nd 2 组薄膜,经 650 ℃退火处理后,对样品进行了 XRD 和 VSM 测试分析。结果表明:对于 Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo 多层薄膜,当 NdFeB/Nd 厚度比为 6/5 时,薄膜的内禀矫顽力最好,平行和垂直方向的内禀矫 顽力分别为 14.5×79.6 和 10.5×79.6 kA·m⁻¹;对于 Mo/[NdFeB/Nd]*n*/Mo (*n*=2, 5, 8, 10; NdFeB/Nd 厚度比为 6/5)交替多层薄膜,当周期 *n* 为 8 时,薄膜具有最好的磁性能,平行和垂直方向的内禀矫顽力分别为 21.3×79.6 和 16.7×79.6 kA·m⁻¹;对于 NdFeB/Nd 厚度比均为 6/5 的薄膜,交替多层膜的综合磁性能高于多层膜。

关键词:磁控溅射;NdFeB/Nd 薄膜;磁性能

中图法分类号: TM271; O484.4⁺3

文献标识码: A

文章编号: 1002-185X(2017)01-0270-04

随着电子器件及系统向微、精、薄、高可靠和智能化 方向发展,NdFeB 薄膜在微型电机、磁记录、传感器和 微波电路等方面显示出了良好的应用前景^[1],在近十多年 来成为人们研究的热点^[2]。

目前,NdFeB 薄膜的制备方法主要有磁控溅射法(直流和射频溅射)、脉冲激光沉积法、分子束外延法和离子 束溅射法等。20世纪70年代迅速发展起来的磁控溅射法 具有制膜密度高和可控性好等优点,在 NdFeB 薄膜的制 备中得到了广泛的应用^[3]。

Y. B. Kim^[4]和 T. V. Khoa^[5]研究了 Nd/Fe 含量比对 NdFeB 薄膜微观结构和磁性能的影响, M. J. Kim^[6]分析了 NdFeB/Nd 厚度比对 Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta 薄膜磁性能的影 响, 但是对于[NdFeB/Nd]n 交替多层薄膜研究的较少。J. T. Tsai^[7]报道了 NdFeB 层和 Nb 层总厚度均保持不变的 [(NdFeB)*x*(Nb)*z*]*n* 交替多层薄膜,由于周期*n* 的增加使得 矫顽力有了很大的提高。

本研究采用磁控溅射法在相同的工艺参数下制备了 Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo多层薄膜和Mo/[NdFeB/Nd]n/Mo交 替多层薄膜,分析了 NdFeB/Nd 厚度比对多层薄膜微观结 构和磁性能的影响,确定了最佳厚度比,观察了最佳厚度 比下不同周期交替多层薄膜磁性能的变化,以寻求 NdFeB/Nd 薄膜最佳的复合方式。

1 实 验

采用 FJL560 II 型超高真空磁控与离子束联合溅射

设备进行制膜。基底为 P 型 Si(110),溅射前先分别用乙 醇和丙酮超声清洗 15 min,然后立即烘干放入磁控溅射 室。采用 Nd₂Fe₁₄B 粉末烧结靶、纯 Mo 靶(纯度 99.99%) 和纯 Nd 靶(纯度 99.99%)进行溅射。溅射时靶/基距均 为7 cm,背底真空度优于 2.0×10⁴ Pa。NdFeB 和 Mo 采 用直流靶溅射,功率分别为 40 和 30 W, Nd 采用射频靶 溅射,功率为 80 W。溅射态薄膜在 3.0×10⁴ Pa 的真空环 境中进行退火,退火温度为 650 ℃,保温时间为 30 min。

采用 PANalytica X' PERT PRO SUPER X 射线衍射 仪(XRD)对样品进行物相测试,射线源为 Cu 靶的 Ka 射 线, λ =0.1541 nm;采用 Quantum DeSign 公司生产的 Verslab 振动样品磁强计(VSM)对样品进行磁性能测试, 最大外磁场为 2.9 T。

2 结果与讨论

2.1 不同 NdFeB/Nd 厚度比对多层薄膜的微观结构和磁 性能的影响

为了解不同 NdFeB/Nd 厚度比对多层薄膜的微观结构和磁性能的影响,制备了不同 NdFeB/Nd 厚度比 *R*(*R*=3/5,6/5,9/5,12/5,15/5)的 Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo 多层 薄膜。

图 1 为不同 NdFeB/Nd 厚度比 *R* 下的多层薄膜经 650 ℃退火后的 XRD 图谱。可以看出,在 2*θ*=30 °出现 了很强的富 Nd 相峰,说明薄膜中存在面心立方的富 Nd 相。所有薄膜均出现了很强的 Nd₂Fe₁₄B 相(312)、(404)

收稿日期: 2015-12-20

基金项目: 教育部高等学校博士点基金 (20101415110003); 山西省自然科学基金 (2008011042-2); 山西省回国留学人员科研资助项目 (2013-098)

作者简介:张敏刚,男,1962年生,博士,教授,太原科技大学材料科学与工程学院先进材料研究所,山西太原 030024,电话:0351-2161126, E-mail: am_lab@yeah.net



图 1 不同厚度比 R 下 Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo 薄膜的 XRD 图谱 Fig.1 XRD patterns of Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo thin films with various thickness ratio R

(008)峰, 且 R 为 6/5 时薄膜的峰强为最高,还出现了相 对较弱的 Nd₂Fe₁₄B 相(410)、(116)和(324)峰,说明薄膜 晶化得很好。然而,对于 Li 等人^[8] 在单层 NdFeB 薄膜 中观察到的 Nd₂Fe₁₄B 相(004)、(105)和(006)强衍射峰, 在图 1 中均没有观察到,说明多层薄膜的垂直取向不太 明显。

图 2 为不同 NdFeB/Nd 厚度比 R 下多层薄膜内禀矫 顽力的变化曲线。可以看出,薄膜均有良好的矫顽力, 且平行方向的内禀矫顽力远远大于垂直方向的。随着厚 度比 R 的增大,薄膜平行方向的内禀矫顽力先增大后略 微减小,最后快速减小,垂直方向也是先增大后减小。 当厚度比 R 为 6/5 时,薄膜平行和垂直方向的内禀矫顽 力均为最大,分别为 14.5×79.6 和 10.5×79.6 kA·m⁻¹。这 与图 1 中薄膜的微观结构相对应。当厚度比 R 大于 12/5 以后,薄膜平行和垂直方向的内禀矫顽力均迅速减小。 这可能是由于 NdFeB 层太厚,相对 Nd 的含量减少,导 致生成的 Nd₂Fe₁₄B 硬磁性相的数量减少。



图 2 不同厚度比 *R* 下 Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo 薄膜的 内禀矫顽力变化曲线



various thickness ratio R

图 3 为 NdFeB/Nd 厚度比 *R* 为 6/5 的多层薄膜的磁 滞回线。可以看出,薄膜在平行方向的磁滞回线有很好 的方形度,而且正如 M. J. Kim^[6]报道的薄膜平行方向的 内禀矫顽力优于垂直方向的。然而,W. B. Cui^[9]研究的 Nd₁₅Fe₇₅B₁₀ (80 nm)/Nd (20 nm)多层薄膜表明,垂直方向 的内禀矫顽力比较大。本研究出现的情况可能是由于过 厚的 Nd 层影响了 NdFeB 晶粒的 *c* 轴织构的形成^[10,11], 使得 *c* 轴取向发生了偏转。这与在图 1 中得出的薄膜的 垂直取向不明显相对应。

2.2 NdFeB/Nd 厚度比恒定不同周期下交替多层薄膜磁 性能的变化

为了解厚度比恒定不同周期下薄膜磁性能的变化, 在上节中得到的最佳 NdFeB/Nd 厚度比 *R* 为 6/5、NdFeB 层和 Nd 层总厚度均保持不变的条件下,制备了 Mo/[NdFeB/Nd]*n*/Mo (*n*=2, 5, 8, 10)交替多层薄膜。

图 4 为不同周期 n 下交替多层薄膜内禀矫顽力的变 化曲线。可以看出,随着周期 n 的增大,薄膜平行方向 的内禀矫顽力先增大后减小,当周期 n 为 8 时,矫顽力





thickness ratio R=6/5



图 4 Mo/[NdFeB/Nd]n/Mo(n=2, 5, 8, 10) 薄膜的内禀矫顽力 变化曲线

Fig.4 Variation of H_{cJ} of Mo/[NdFeB/Nd]n/Mo (n=2, 5, 8, 10)

thin films

最大,为21.3×79.6 kA·m⁻¹;垂直方向的内禀矫顽力先略 微减小然后快速增大,最后又减小,也是周期 n 为8时, 矫顽力最大,为16.7×79.6 kA·m⁻¹。

图 5 为不同周期 n 下交替多层薄膜平行方向的 J-H 退磁曲线。可以看出不同周期 n 下,薄膜退磁曲线的方 形度均很好,且退磁曲线上的弯曲点磁场 H_k在 n 为 8 时最大。故周期 n 为 8 时,薄膜的内禀矫顽力和退磁曲 线方形度均达到最好。

2.3 多层及交替多层薄膜各项磁性能参数的对比

表1为多层及交替多层薄膜的各项磁性能参数。可以 看出,交替多层薄膜的内禀矫顽力 *H*_{cJ}、剩磁比 *M*_r/*M*_s和 最大磁能积(*BH*)_{max}均要优于多层薄膜。

图 6 为在同一条件下测得的厚度比 *R* 为 6/5 的多层 薄膜(a)和交替多层薄膜(b)的 XRD 图谱。可以看 出,交替多层薄膜的富 Nd 相峰和 Nd₂Fe₁₄B 相峰的强度 均要比多层薄膜的高。在交替多层薄膜(b)中观察到了 较弱的 Nd₂Fe₁₄B 相(004)峰。说明交替多层薄膜的结晶 形态要比多层薄膜的好。

得到上述结果的原因可能是: 多层薄膜的 Nd 层作 为补充层扩散到 NdFeB 层,促进了 Nd₂Fe₁₄B 硬磁性相 的生成,但可能 Nd 层不是全部被有效利用。交替多层 膜的 Nd 层和 NdFeB 层在每个周期中厚度相对较薄,扩



- 图 5 Mo/[NdFeB/Nd]n/Mo(n=2, 5, 8, 10) 薄膜平行方向的 *J-H* 退磁曲线
- Fig.5 Parallel *J-H* demagnetization curves of Mo/[NdFeB/Nd]*n*/ Mo (*n*=2, 5, 8, 10) thin films

表 1 多层及交替多层薄膜的各向磁性能参数 Table 1 Various magnetic parameters of multilayer and alternative multilayer thin films

uter hut ve mutthujer tilli hills		
Magnetic parameter	Multilayer	Alternative multilayer
	(<i>R</i> =6/5)	(<i>R</i> =6/5, <i>n</i> =8)
$//H_{cJ}/\times 79.6 \text{ kA} \cdot \text{m}^{-1}$	14.5	21.3
$_{\perp}H_{\rm cJ}$ /×79.6 kA·m ⁻¹	10.5	16.7
$//M_{\rm r}/M_{\rm s}$	0.82	0.95
$_{\perp}M_{ m r}/M_{ m s}$	0.76	0.87
//(<i>BH</i>) _{max} /×7.96 kJ·m ⁻³	10.9	13.0



图 6 厚度比 *R* 为 6/5 的 Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo 薄膜和 Mo/[NdFeB/Nd]8/Mo 薄膜的 XRD 图谱

Fig.6 XRD patterns of Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo thin films (a) and Mo/[NdFeB/Nd]8/Mo (b) with thickness ratio R=6/5

散更加充分,Nd 层被最大限度的利用。Nd 层在作为补 充层的同时,使得 NdFeB 晶粒边界上出现了薄层富 Nd 相,从而有效地隔离了 NdFeB 硬磁性晶粒,阻止了相邻 硬磁性晶粒间的交换耦合作用^[12,13],也抑制了 NdFeB 晶 粒的长大。除此之外,可能正如 J. T. Tsai^[7]分析指出, [(NdFeB)*x*(Nb)*z*]*n* 交替多层膜的 NdFeB 晶粒尺寸也受到 NdFeB 层厚度的影响。因此,可以得出薄膜的复合方式 会影响富 Nd 相的分布和数量,也会影响 NdFeB 晶粒的 尺寸,进而影响薄膜的磁性能,但是微观机理还有待于 进一步的研究。

3 结 论

1) Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo 多层薄膜随着 NdFeB/Nd 厚度比 *R* 的增大,薄膜平行和垂直方向的内禀矫顽力先 增大后减小。当 *R* 为 6/5 时,薄膜的内禀矫顽力最好。

2) 厚度比 R 为 6/5 的 Mo/[NdFeB/Nd]n/Mo 交替多 层薄膜随着周期 n 的增大,薄膜平行和垂直方向的内禀 矫顽力先增大后减小。当 n 为 8 时,薄膜的内禀矫顽力 最好。

3) NdFeB/Nd 厚度比为 6/5 的薄膜,周期 n 为 8 的交替多层膜的综合磁性能高于多层膜。

参考文献 References

- Cho H J, Ahn C H. Journal of Microelectronic Mechanical System
 [J], 2002, 11: 78
- [2] Fu Mingxi(傅明喜), Zong Hua(宗华), Li Yan(李岩) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2006, 35(7): 1109
- [3] Yang Bangchao(杨邦朝), Wang Wensheng(王文生). Film Physics

and Technology(薄膜物理与技术)[M]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology Press, 1994: 60

- [4] Kim Y B, Kim M J, Ryu K S et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials[J], 2001, 234: 489
- [5] Khoa T V, Haa N D, Honga S M et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials[J], 2006, 304: 246
- [6] Kim M J, Li Y, Kim Y B et al. IEEE Transactions on Magnetics[J], 2000, 9: 3370
- [7] Tsai J T, Yao Y D, Chin T S et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials[J], 2002, 239: 450
- [8] Li D S, Suzuki S, Liu W F et al. Materials Science and Engineering[J], 2009, 1: 12
- [9] Cui W B, Takahashi Y K, Hono K et al. Acta Materilia[J], 2011,

59: 7768

- [10] Chandrasekhar R, Mapps D, Grady K O et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials[J], 1999, 196: 104
- [11] Lileev A S, Parilov A A, Blatov V G et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials[J], 2002, 242-245: 1300
- [12] Shinba Y, Konno T J, Ishikawa K et al. Journal of Applied Physics[J], 2005, 97(5): 53 504
- [13] Liu W F, Ohkubo T, Hono H et al. Acta Materilia[J], 2009, 57(5): 1337

Magnetic Properties of Multilayer and Alternative Multilayer NdFeB/Nd Thin Films

Zhang Mingang, Liu Li, Chen Fenghua, Li Minjie (Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan 030024, China)

Abstract: Two types of NdFeB/Nd thin films were deposited by a magnetron sputtering method. After annealing at 650 °C, the samples were analyzed by XRD and VSM. Results show that the Mo/Nd/NdFeB/Nd/Mo multilayer thin film with the thickness ratio of NdFeB/Nd=6/5 exhibits high coercivity. The parallel and perpendicular coercivity of multilayer films are 14.5×79.6 kA·m⁻¹ and 10.5×79.6 kA·m⁻¹, respectively. The Mo/[NdFeB/Nd]*n*/Mo (*n*=2, 5, 8, 10, NdFeB/Nd=6/5) alternative multilayer thin film with *n*=8 shows good hard magnetic properties. The parallel and perpendicular coercivity of the alternative multilayer thin film are 21.3×79.6 kA·m⁻¹ and 16.7×79.6 kA·m⁻¹, respectively. The magnetic properties of the alternative multilayer film with thickness ratio of NdFeB/Nd=6/5 are enhanced in comparison with the multilayer film. **Key words:** magnetron sputtering; NdFeB/Nd thin films; magnetic properties

Corresponding author: Zhang Mingang, Ph. D., Professor, Institute of Advanced Materials, College of Materials Science and Engineering, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan 030024, P. R. China, Tel: 0086-351-2161126, E-mail: am_lab@yeah.net